

Монокристаллы арсенида галлия



Технические характеристики

Метод выращивания	VGF
Номинальный диаметр, мм	100
Отклонение от номинала, мкм	+1/-0
Кристаллографическая ориентация, °	(100)
Тип проводимости	N
Легирующая примесь	Si
Подвижность носителей заряда, см²/В·сек	> 1200
Концентрация носителей заряда, см-3	От 1·1017 до 3·1018
Плотность дислокаций, см-2	< 500